


	<h2 style="color: red;">SI5406CDC-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5406CDC-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 12V 6A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5406CDC-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5406CDC-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 6A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 6.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 5.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5406CDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5406CDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5406CDC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5406CDC-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5406DC-T1-E3-S</b> VISHAY SI5406DC-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p><b>SI5404BDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 5.4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5406CDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 6A 1206-8</p>	 <p><b>SI5404DC-T1-E3</b> 1206-8 SI5404DC-T1-E3 1206-8</p>
 <p><b>SI5406DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 6.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5406DC-T1</b> VISHAY SI5406DC-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI5404DC</b> VISHAY SI5404DC VISHAY</p>	 <p><b>SI5406DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 6.9A 1206-8</p>

### SI5406CDC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI5406CDC-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI5406CDC-T1-GE3 Datenblatt	SI5406CDC-T1-GE3-Datenblätter	SI5406CDC-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5406CDC-T1-GE3
SI5406CDC-T1-GE3 Electronic	SI5406CDC-T1-GE3-Komponenten	SI5406CDC-T1-GE3-Verteiler	SI5406CDC-T1-GE3-Bild	SI5406CDC-T1-GE3-Teil
SI5406CDC-T1-GE3 Preis	SI5406CDC-T1-GE3 Hersteller	SI5406CDC-T1-GE3 Bild	SI5406CDC-T1-GE3 Aktie	SI5406CDC-T1-GE3 Inventar
SI5406CDC-T1-GE3 Neu	SI5406CDC-T1-GE3 Original	SI5406CDC-T1-GE3 garantiert	SI5406CDC-T1-GE3 RFQ	SI5406CDC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited